



BCF 32 BCF 33

Rauscharme

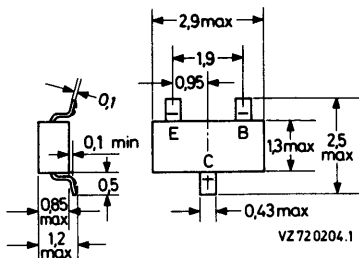
SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff, SOT-23
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: BCF 32: D 7
BCF 33: D 8

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung	$U_{CB0} = \text{max.}$	30	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$U_{CE0} = \text{max.}$	20	V
Kollektorstrom, Scheitelwert	$I_{CM} = \text{max.}$	200	mA
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}} = \text{max.}$	200	mW
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max.}$	150	$^\circ\text{C}$

Gleichstromverstärkung

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 2\text{ mA}$

	<u>BCF 32</u>	<u>BCF 33</u>
B	= 200...450	420...800

Transit-Frequenz

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$

$f_T = 300\text{ MHz}$

Rauschzahl

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 200\text{ }\mu\text{A}$, $f = 1\text{ kHz}$

$F \leq 4\text{ dB}$

BCF 32

BCF 33

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_{J \max}$)

Kollektor-Sperrspannung bei $I_E = 0$:

$$U_{CB 0} = \max. \quad 30 \text{ V}$$

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

bei $I_B = 0, I_C = 2 \text{ mA}$:

$$U_{CE 0} = \max. \quad 20 \text{ V}$$

Emitter-Sperrspannung bei $I_C = 0$:

$$U_{EB 0} = \max. \quad 5 \text{ V}$$

Kollektorstrom, Mittelwert:

$$I_{C \text{ AV}} = \max. \quad 100 \text{ mA}$$

Kollektorstrom, Scheitelwert:

$$I_{C \text{ M}} = \max. \quad 200 \text{ mA}$$

Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$: ¹⁾

$$P_{\text{tot}} = \max. \quad 200 \text{ mW}$$

Sperrschichttemperatur:

$$\vartheta_J = \max. \quad 150 \text{ }^\circ\text{C}$$

Lagerungstemperatur:

$$\vartheta_S = \min. \quad -65 \text{ }^\circ\text{C}$$

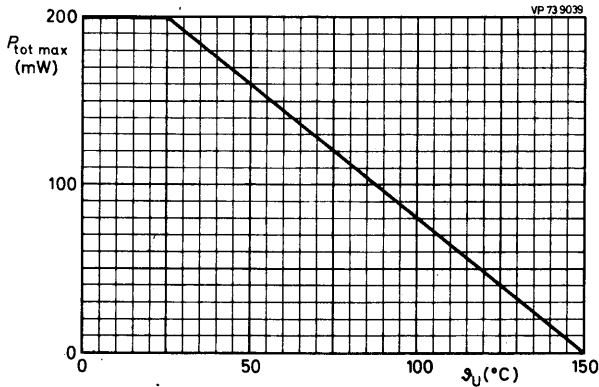
$$\vartheta_S = \max. \quad 150 \text{ }^\circ\text{C}$$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: ¹⁾

$$R_{\text{th U}} \leq 0,62 \text{ K/mW}$$

¹⁾ Transistor auf Keramik-Substrat von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm



BCF 32

BCF 33

Kennwerte:

bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

BCF 32

BCF 33

Kollektor-Reststrom

bei $I_E = 0$, $U_{CB} = 20\text{ V}$:

$I_{CB0} \leq 100\text{ nA}$

bei $I_E = 0$, $U_{CB} = 20\text{ V}$, $\vartheta_J = 100^\circ\text{C}$:

$I_{CB0} \leq 10\text{ }\mu\text{A}$

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0,5\text{ mA}$:

$U_{CE\text{ sat}} = 120 (\leq 250)\text{ mV}$

bei $I_C = 50\text{ mA}$, $I_B = 2,5\text{ mA}$:

$U_{CE\text{ sat}} = 210\text{ mV}$

Basisspannung

bei $I_C = 10\text{ mA}$, $I_B = 0,5\text{ mA}$:

$U_{BE\text{ sat}} = 750\text{ mV}$

bei $I_C = 50\text{ mA}$, $I_B = 2,5\text{ mA}$:

$U_{BE\text{ sat}} = 850\text{ mV}$

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 2\text{ mA}$:

$U_{BE} = 550 \dots 700\text{ mV}$

Gleichstromverstärkung

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 10\text{ }\mu\text{A}$:

$B = 150 \dots 270$

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 2\text{ mA}$:

$B = 200 \dots 450 \quad 420 \dots 800$

Transit-Frequenz

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$, $f_M = 35\text{ MHz}$:

$f_T = 300\text{ MHz}$

Kollektorkapazität

bei $U_{CB} = 10\text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 1\text{ MHz}$:

$C_c \leq 4\text{ pF}$

Rauschzahl

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 200\text{ }\mu\text{A}$

und $R_g = 2\text{ k}\Omega$, $f = 1\text{ kHz}$, $B = 200\text{ Hz}$:

$F = 1,2 (\leq 4)\text{ dB}$

Kennlinien siehe BCW 31/32/33

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Komplementärtypen zu BCP 54/55/56

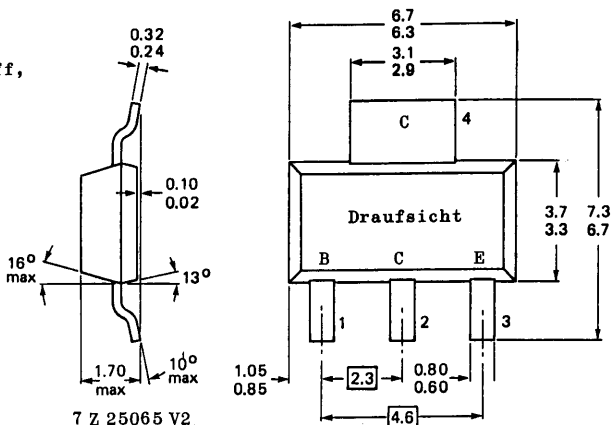
Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff,
SOT-223

Stempel:

- BCP 51: AA
- BCP 51-10: AC
- BCP 51-16: AD
- BCP 52: AE
- BCP 52-10: AG
- BCP 52-16: AM
- BCP 53: AH
- BCP 53-10: AK
- BCP 53-16: AL

Maßangaben in mm.



7 Z 25065 V2

<u>Kurzdaten:</u>		BCP 51	BCP 52	BCP 53
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$-U_{CE0} = \text{max.}$	45	60	80
Kollektorstrom, Scheitelwert	$-I_{CM} = \text{max.}$		1,5	A
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$	$P_{tot} = \text{max.}$		1,5	W
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max.}$		150	$^\circ\text{C}$
Gleichstromverstärkung bei $-U_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 150\text{ mA}$	B =	40...250		
Transit-Frequenz bei $-U_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 10\text{ mA}$	$f_T =$	50 MHz		

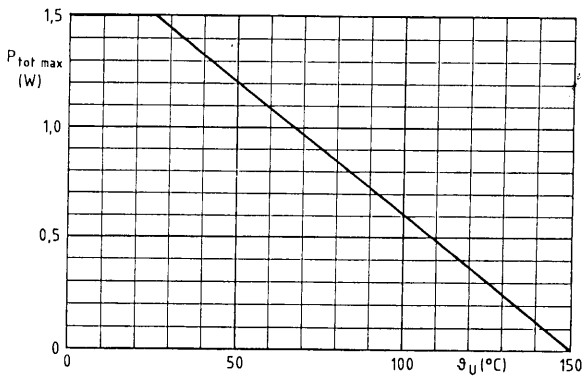
BCP 51 BCP 52 BCP 53

Absolute Grenzwerte:

		BCP 51	BCP 52	BCP 53
Kollektor-Sperrspannung bei $I_E = 0$:	$-U_{CB 0} = \text{max.}$	45	60	100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$:	$-U_{CE R} = \text{max.}$	45	60	100 V
	bei $I_B = 0$:	$-U_{CE 0} = \text{max.}$	45	60
Emitter-Sperrspannung bei $I_C = 0$:	$-U_{EB 0} = \text{max.}$		5	V
Kollektorstrom, Mittelwert:	$-I_{C AV} = \text{max.}$		1,0	A
Kollektorstrom, Scheitelwert:	$-I_{C M} = \text{max.}$		1,5	A
Basisstrom, Mittelwert:	$-I_{B AV} = \text{max.}$		0,1	A
Basisstrom, Scheitelwert:	$-I_{B M} = \text{max.}$		0,2	A
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$:	$P_{\text{tot}} = \text{max.}$		1,5	W
Sperrschichttemperatur:	$\vartheta_J = \text{max.}$		150	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperatur:	$\vartheta_S = \text{min.}$		-65	$^\circ\text{C}$
	$\vartheta_S = \text{max.}$		150	$^\circ\text{C}$

Wärmeleiterstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:	$R_{th U} \leq$	83,3	K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektoranschluß:	$R_{th C} \leq$	10	K/W



¹⁾ Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm mit min. 6 cm² Kupferfläche für den Kollektoranschluß

BCP 51 BCP 52 BCP 53

Kennwerte: bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei $I_E = 0, -U_{CB} = 30\text{ V}$:

$$-I_{CB0} \leq 100\text{ nA}$$

bei $I_E = 0, -U_{CB} = 30\text{ V}, \vartheta_J = 125^\circ\text{C}$:

$$-I_{CB0} \leq 10\text{ }\mu\text{A}$$

Emitter-Reststrom

bei $I_C = 0, -U_{EB} = 5\text{ V}$:

$$-I_{EB0} \leq 10\text{ }\mu\text{A}$$

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei $-I_C = 500\text{ mA}, -I_B = 50\text{ mA}$:

$$-U_{CE\text{ sat}} \leq 0,5\text{ V}$$

Basisspannung

bei $-U_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 500\text{ mA}$:

$$-U_{BE} \leq 1,0\text{ V}$$

Transit-Frequenz

bei $-U_{CE} = 5\text{ V}, -I_C = 10\text{ mA}, f_M = 35\text{ MHz}$:

$$f_T = 50\text{ MHz}$$

Gleichstromverstärkung

bei $-U_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 5\text{ mA}$:

$$B \geq 25$$

bei $-U_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 150\text{ mA}$:

$$B = 40 \dots 250$$

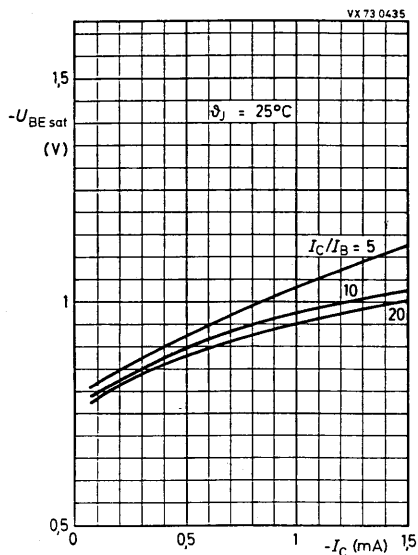
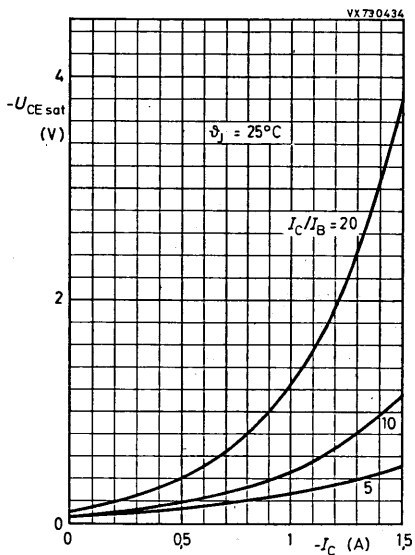
bei $-U_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 500\text{ mA}$:

$$B \geq 25$$

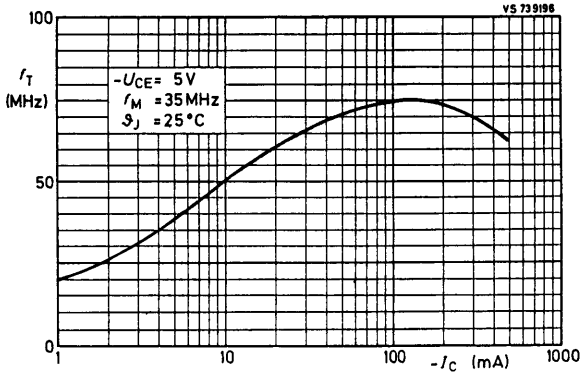
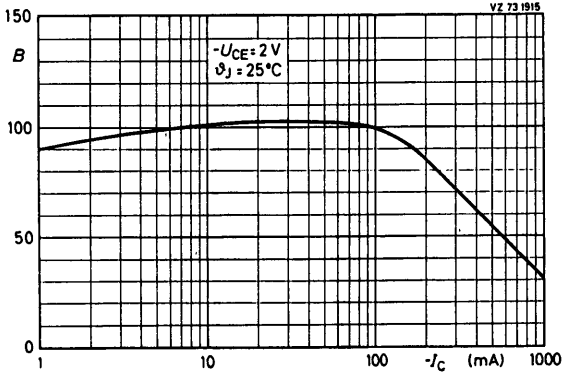
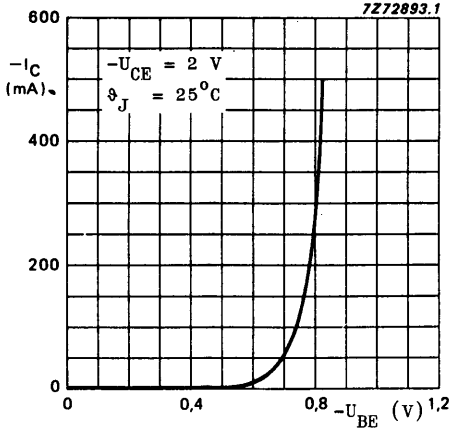
bei $-U_{CE} = 2\text{ V}, -I_C = 150\text{ mA}$:

$$\text{BCP 51/52/53 - 10: } B = 63 \dots 160$$

$$\text{BCP 51/52/53 - 16: } B = 100 \dots 250$$



BCP 51
BCP 52
BCP 53



SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Komplementärtypen zu BCP 51/52/53

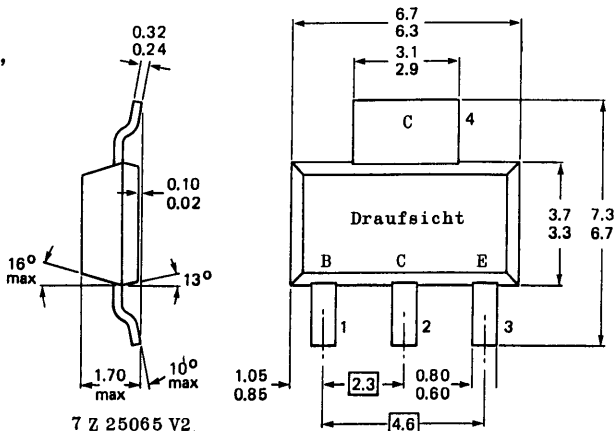
Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff,
SOT-223

Stempel:

- BCP 54: BA
- BCP 54-10: BC
- BCP 54-16: BD
- BCP 55: BE
- BCP 55-10: BG
- BCP 55-16: BM
- BCP 56: BJ
- BCP 56-10: BK
- BCP 56-16: BL

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

		BCP 54	BCP 55	BCP 56	
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$U_{CE0} = \text{max.}$	45	60	80	V
Kollektorstrom, Scheitelwert	$I_{CM} = \text{max.}$		1,5		A
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$	$P_{tot} = \text{max.}$		1,5		W
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max.}$		150		$^\circ\text{C}$
Gleichstromverstärkung bei $U_{CE} = 2\text{ V}$, $I_C = 150\text{ mA}$	B =		40...250		
Transit-Frequenz bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$	$f_T =$		130		MHz

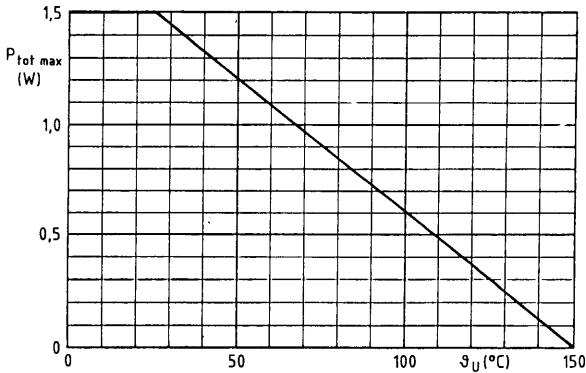
BCP 54
BCP 55
BCP 56

Absolute Grenzwerte:

		BCP 54	BCP 55	BCP 56
Kollektor-Sperrspannung bei $I_E = 0$:	$U_{CB 0} = \text{max.}$	45	60	100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei $R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$:	$U_{CE R} = \text{max.}$	45	60	100 V
	bei $I_B = 0$:	$U_{CE 0} = \text{max.}$	45	60
Emitter-Sperrspannung bei $I_C = 0$:	$U_{EB 0} = \text{max.}$		5	V
Kollektorstrom, Mittelwert:	$I_{C AV} = \text{max.}$		1,0	A
Kollektorstrom, Scheitelwert:	$I_{C M} = \text{max.}$		1,5	A
Basisstrom, Mittelwert:	$I_{B AV} = \text{max.}$		0,1	A
Basisstrom, Scheitelwert:	$I_{B M} = \text{max.}$		0,2	A
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$: ¹⁾	$P_{tot} = \text{max.}$		1,5	W
Sperrschichttemperatur:	$\vartheta_J = \text{max.}$		150	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperatur:	$\vartheta_S = \text{min.}$		-65	$^\circ\text{C}$
	$\vartheta_S = \text{max.}$		150	$^\circ\text{C}$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: ¹⁾	$R_{th U} \leq$	83,3	K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektoranschluß:	$R_{th C} \leq$	10	K/W



¹⁾ Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm mit min. 6 cm² Kupferfläche für den Kollektoranschluß

Kennwerte: bei $\vartheta_U = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

bei $I_E = 0$, $U_{CB} = 30\text{ V}$:

$$I_{CB0} \leq 100 \text{ nA}$$

bei $I_E = 0$, $U_{CB} = 30\text{ V}$, $\vartheta_J = 125^\circ\text{C}$:

$$I_{CB0} \leq 10 \text{ }\mu\text{A}$$

Emitter-Reststrom

bei $I_C = 0$, $U_{EB} = 5\text{ V}$:

$$I_{EB0} \leq 10 \text{ }\mu\text{A}$$

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei $I_C = 500\text{ mA}$, $I_B = 50\text{ mA}$:

$$U_{CE\text{ sat}} \leq 0,5 \text{ V}$$

Basisspannung

bei $U_{CE} = 2\text{ V}$, $I_C = 500\text{ mA}$:

$$U_{BE} \leq 1,0 \text{ V}$$

Transit-Frequenz

bei $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 10\text{ mA}$, $f_M = 35\text{ MHz}$:

$$f_T = 130 \text{ MHz}$$

Gleichstromverstärkung

bei $U_{CE} = 2\text{ V}$, $I_C = 5\text{ mA}$:

$$B \geq 25$$

bei $U_{CE} = 2\text{ V}$, $I_C = 150\text{ mA}$:

$$B = 40 \dots 250$$

bei $U_{CE} = 2\text{ V}$, $I_C = 500\text{ mA}$:

$$B \geq 25$$

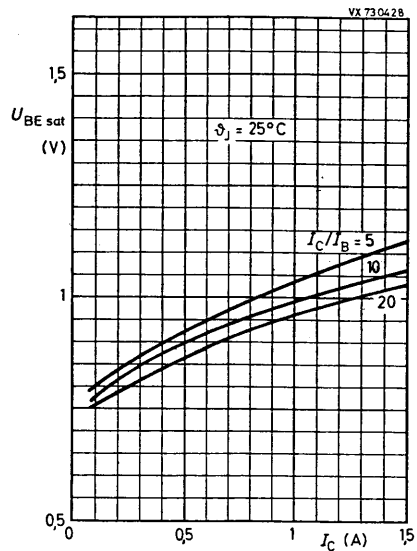
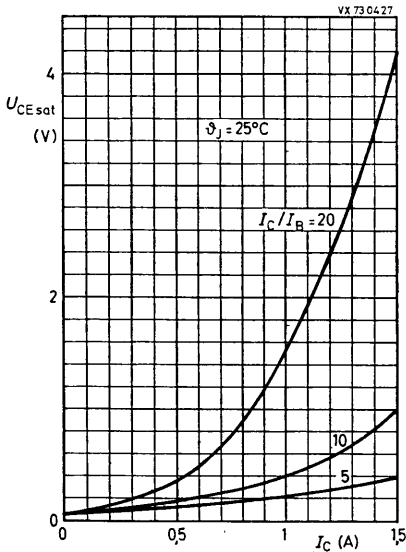
bei $U_{CE} = 2\text{ V}$, $I_C = 150\text{ mA}$:

BCP 54/55/56 - 10:

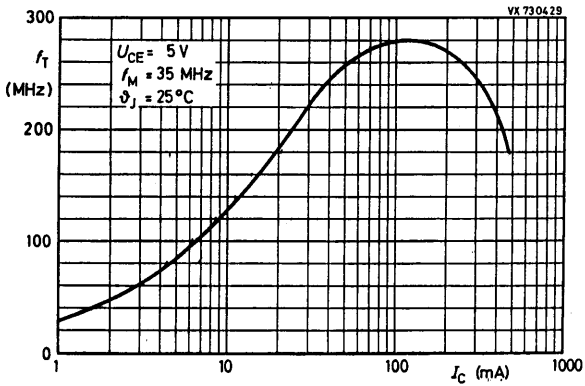
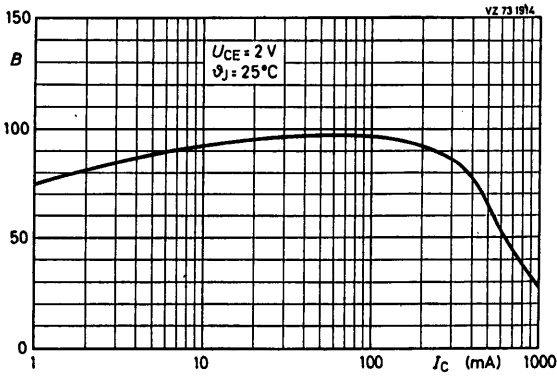
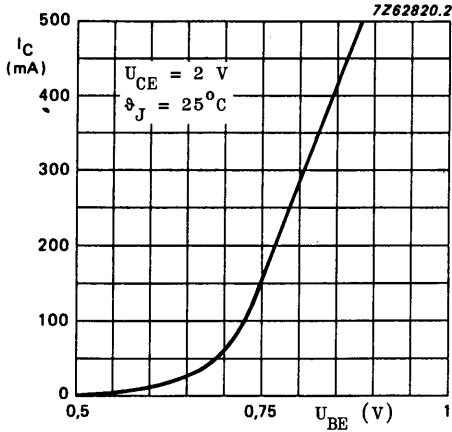
$$B = 63 \dots 160$$

BCP 54/55/56 - 16:

$$B = 100 \dots 250$$



BCP 54
BCP 55
BCP 56



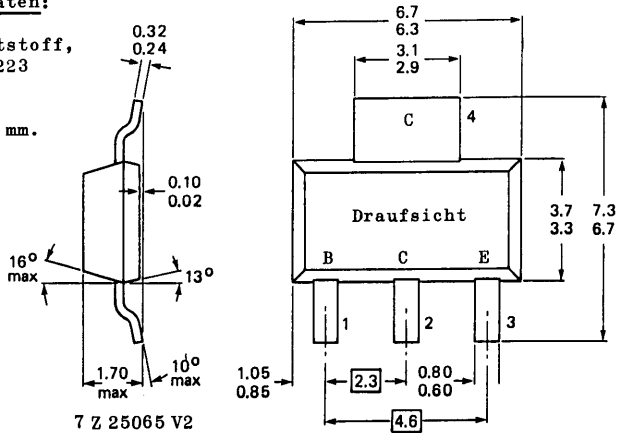
SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR
 für Endstufen kleiner Leistung,
 mit BCP 69 für Komplementärschaltungen

Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff,
 SOT-223

Stempel: CA

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

$U_{CE0} = \text{max. } 20 \text{ V}$

Kollektorstrom, Scheitelwert

$I_{CM} = \text{max. } 2 \text{ A}$

Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$

$P_{tot} = \text{max. } 1,5 \text{ W}$

Sperrschichttemperatur

$\vartheta_J = \text{max. } 150 \text{ }^\circ\text{C}$

Gleichstromverstärkung

bei $U_{CE} = 1 \text{ V}$, $I_C = 500 \text{ mA}$

$B = 85 \dots 375$

Transit-Frequenz

bei $U_{CE} = 5 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$

$f_T = 60 \text{ MHz}$

BCP 68

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_{J \max}$)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei $U_{BE} = 0$:
bei $I_B = 0$:

Emitter-Sperrspannung bei $I_C = 0$:

Kollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom, Mittelwert:

Basisstrom, Scheitelwert:

Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$: 1)

Sperrschichttemperatur:

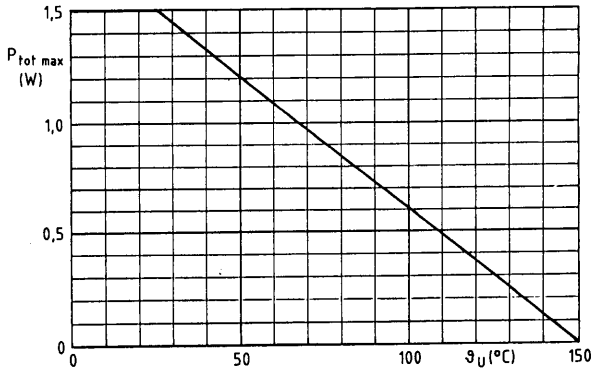
Lagerungstemperatur:

$U_{CE S}$	= max.	25	V
$U_{CE 0}$	= max.	20	V
$U_{EB 0}$	= max.	5	V
$I_{C AV}$	= max.	1	A
$I_{C M}$	= max.	2	A
$I_{B AV}$	= max.	100	mA
$I_{B M}$	= max.	200	mA
P_{tot}	= max.	1,5	W
ϑ_J	= max.	150	$^\circ\text{C}$
ϑ_S	= max.	-65	$^\circ\text{C}$
ϑ_S	= max.	150	$^\circ\text{C}$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

$$R_{th U} \leq 83,3 \text{ K/W}$$

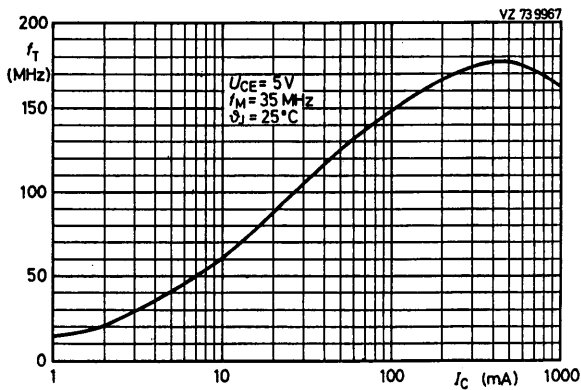
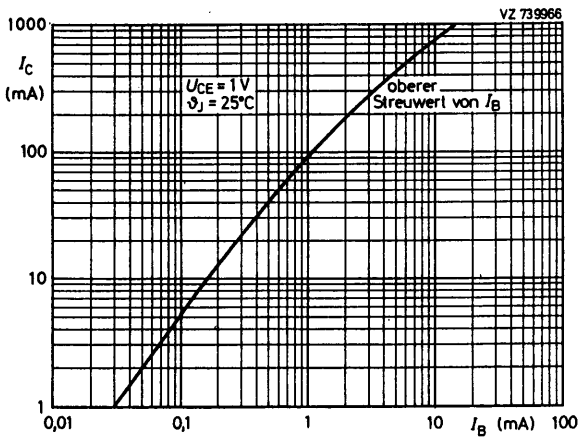
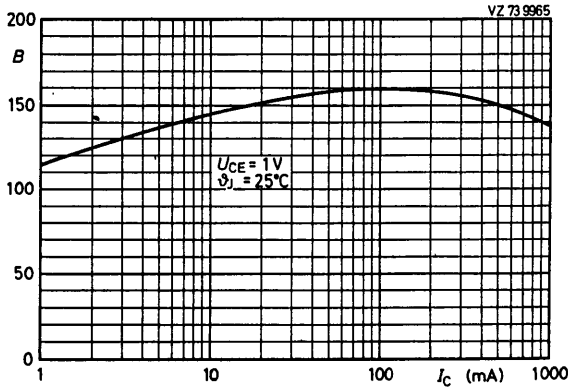


1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm mit min. 6 cm² Kupferfläche für den Kollektoranschluß

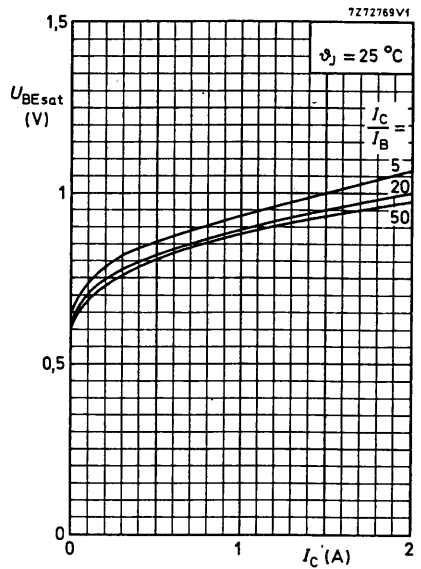
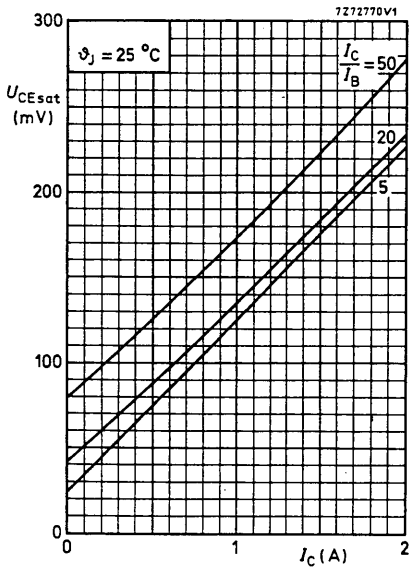
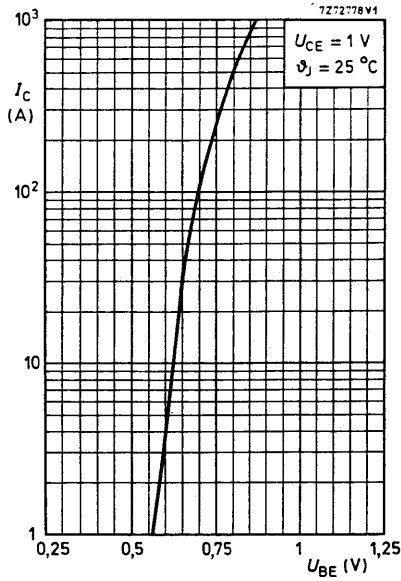
Kennwerte: bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom				
bei $I_E = 0, U_{CB} = 25 \text{ V}$:	$I_{CB} 0$	\leq	10	μA
bei $I_E = 0, U_{CB} = 25 \text{ V}, \vartheta_J = 150^\circ\text{C}$:	$I_{CB} 0$	\leq	1	mA
Emitter-Reststrom				
bei $I_C = 0, U_{EB} = 5 \text{ V}$:	$I_{EB} 0$	\leq	10	μA
Kollektor-Emitter-Restspannung				
bei $I_C = 1 \text{ A}, I_B = 100 \text{ mA}$:	$U_{CE \text{ sat}}$	\leq	0,5	V
Basisspannung				
bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 5 \text{ mA}$:	U_{BE}	$=$	0,62	V
bei $U_{CE} = 1 \text{ V}, I_C = 1 \text{ A}$:	U_{BE}	\leq	1,0	V
Gleichstromverstärkung				
bei $U_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 5 \text{ mA}$:	B	\geq	50	
bei $U_{CE} = 1 \text{ V}, I_C = 500 \text{ mA}$:	B	$=$	85...375	
bei $U_{CE} = 1 \text{ V}, I_C = 1 \text{ A}$:	B	\geq	60	
Transit-Frequenz				
bei $U_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}, f_M = 35 \text{ MHz}$:	f_T	$=$	60	MHz
Kollektorkapazität				
bei $U_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = 0, f = 450 \text{ kHz}$:	C_c	$=$	27	pF

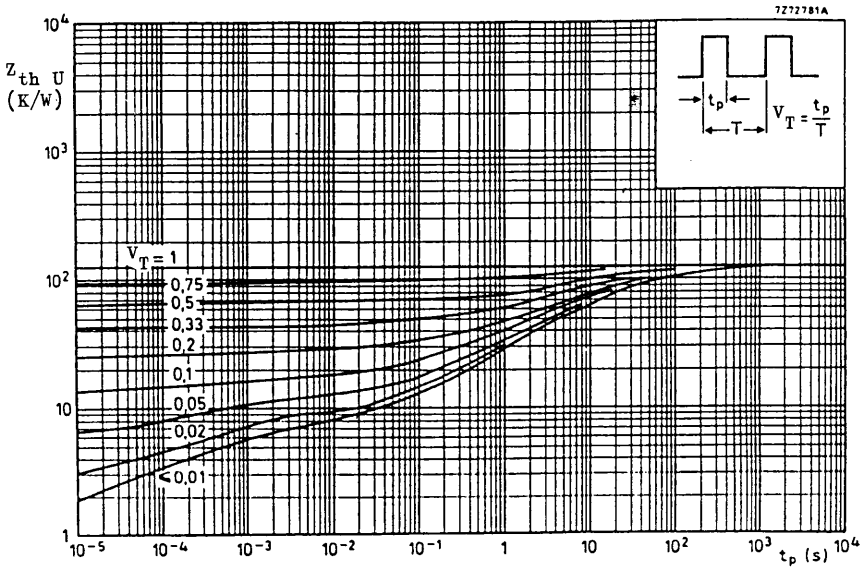
BCP 68



BCP 68



BCP 68



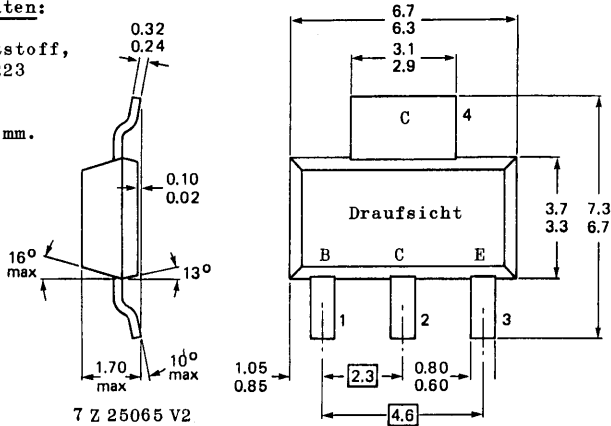
SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - NF - TRANSISTOR
 für Endstufen kleiner Leistung,
 mit BCP 68 für Komplementärschaltungen

Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff,
 SOT-223

Stempel: CE

Maßangaben in mm.



Kurzdaten:

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

$-U_{CE0} = \text{max. } 20 \text{ V}$

Kollektorstrom, Scheitelwert

$-I_{CM} = \text{max. } 2 \text{ A}$

Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$

$P_{\text{tot}} = \text{max. } 1,5 \text{ W}$

Sperrschichttemperatur

$\vartheta_J = \text{max. } 150^\circ\text{C}$

Gleichstromverstärkung

bei $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 500 \text{ mA}$

$B = 85 \dots 375$

Transit-Frequenz

bei $-U_{CE} = 5 \text{ V}$, $-I_C = 10 \text{ mA}$

$f_T = 60 \text{ MHz}$

BCP 69

Absolute Grenzwerte: (gültig bis $\vartheta_{J \max}$)

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei $U_{BE} = 0$:
bei $I_B = 0$:

Emitter-Sperrspannung bei $I_C = 0$:

Kollektorstrom, Mittelwert:

Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom, Mittelwert:

Basisstrom, Scheitelwert:

Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$: 1)

Sperrschichttemperatur:

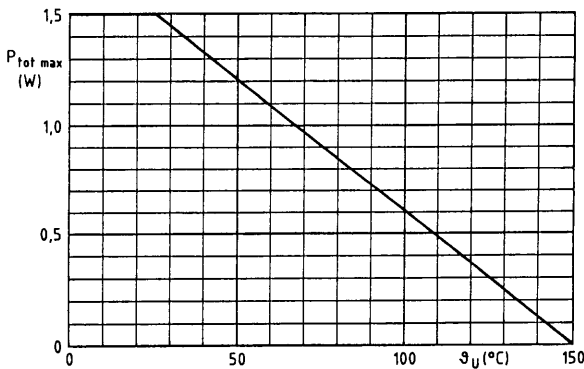
Lagerungstemperatur:

$-U_{CE S}$	= max.	25	V
$-U_{CE 0}$	= max.	20	V
$-U_{EB 0}$	= max.	5	V
$-I_{C AV}$	= max.	1	A
$-I_{C M}$	= max.	2	A
$-I_{B AV}$	= max.	100	mA
$-I_{B M}$	= max.	200	mA
P_{tot}	= max.	1,5	W
ϑ_J	= max.	150	$^\circ\text{C}$
ϑ_S	= min.	-65	$^\circ\text{C}$
ϑ_S	= max.	150	$^\circ\text{C}$

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

$$R_{th U} \leq 83,3 \text{ K/W}$$

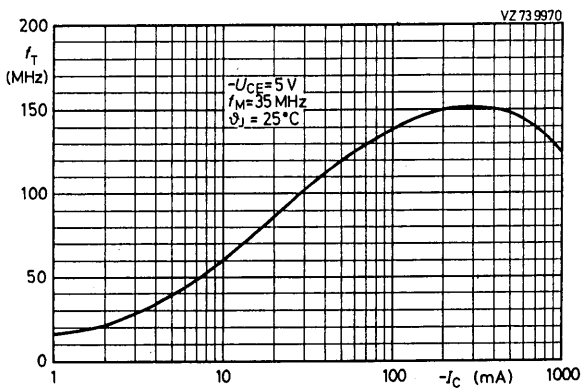
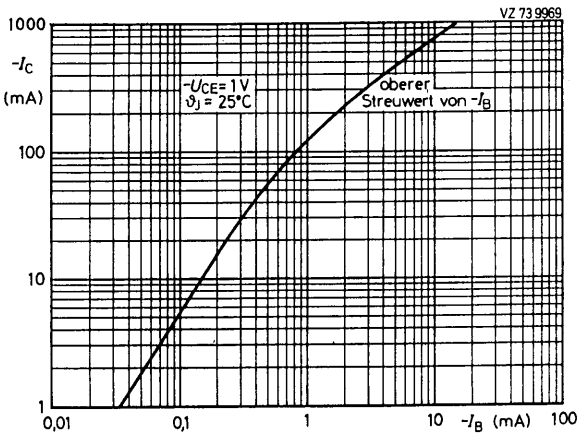
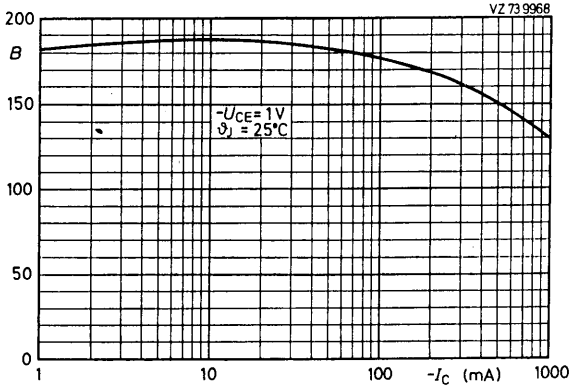


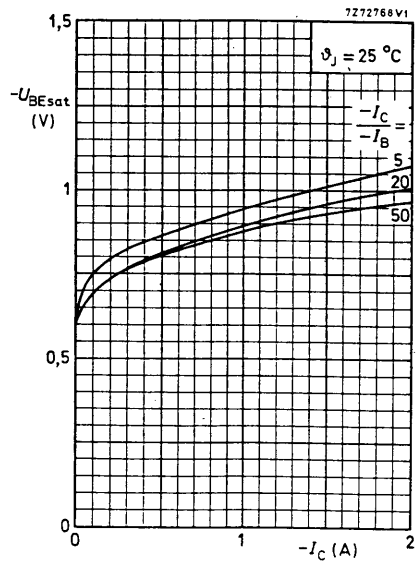
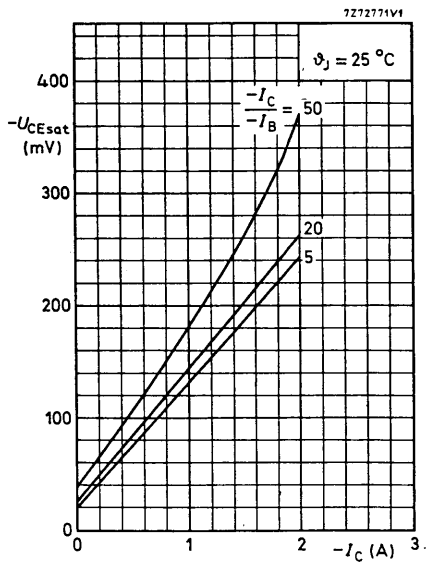
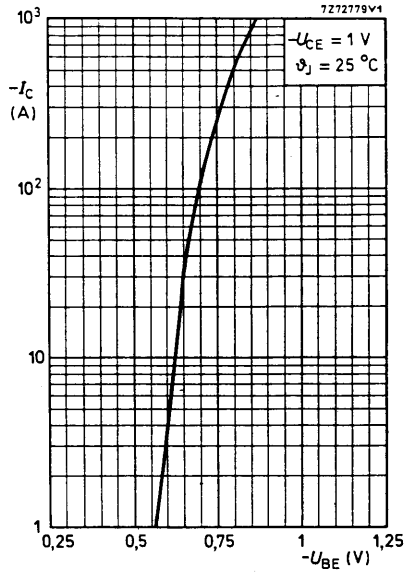
1) Transistor auf Epoxi-Leiterplatte von 40 mm x 40 mm x 1,5 mm mit min. 6 cm² Kupferfläche für den Kollektoranschluß

Kennwerte: bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom				
bei $I_E = 0$, $-U_{CB} = 25\text{ V}$:	$-I_{CB0}$	\leq	10	μA
bei $I_E = 0$, $-U_{CB} = 25\text{ V}$, $\vartheta_J = 150^\circ\text{C}$:	$-I_{CB0}$	\leq	1	mA
Emitter-Reststrom				
bei $I_C = 0$, $-U_{EB} = 5\text{ V}$:	$-I_{EB0}$	\leq	10	μA
Kollektor-Emitter-Restspannung				
bei $-I_C = 1\text{ A}$, $-I_B = 100\text{ mA}$:	$-U_{CE\text{ sat}}$	\leq	0,5	V
Basisspannung				
bei $-U_{CE} = 10\text{ V}$, $-I_C = 5\text{ mA}$:	$-U_{BE}$	$=$	0,62	V
bei $-U_{CE} = 1\text{ V}$, $-I_C = 1\text{ A}$:	$-U_{BE}$	\leq	1,0	V
Gleichstromverstärkung				
bei $-U_{CE} = 10\text{ V}$, $-I_C = 5\text{ mA}$:	B	\geq	50	
bei $-U_{CE} = 1\text{ V}$, $-I_C = 500\text{ mA}$:	B	$=$	85...375	
bei $-U_{CE} = 1\text{ V}$, $-I_C = 1\text{ A}$:	B	\geq	60	
Transit-Frequenz				
bei $-U_{CE} = 5\text{ V}$, $-I_C = 10\text{ mA}$, $f_M = 35\text{ MHz}$:	f_T	$=$	60	MHz
Kollektorkapazität				
bei $-U_{CB} = 5\text{ V}$, $I_E = 0$, $f = 450\text{ kHz}$:	C_c	$=$	45	pF

BCP 69





BCP 69

